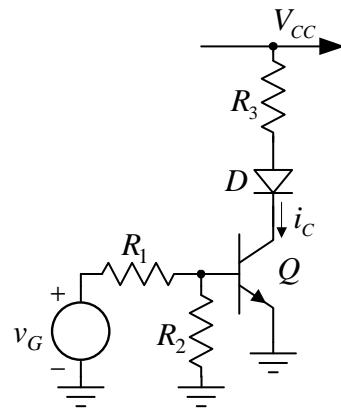


- 1. [10]** Parametri tranzistora u kolu sa slike 1 su: $\beta_F = 100$, $V_\gamma = V_{BE} = V_{BES} = 0,6 \text{ V}$, $V_{CES} = 0,2 \text{ V}$. Dioda je idealna sa parametrom $V_D = 0,6 \text{ V}$, a poznate su i otpornosti otpornika $R_1 = R_2 = 50 \text{ k}\Omega$ i $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$, kao i $V_{CC} = 5 \text{ V}$. Ako se ulazni napon menja u granicama $0 \leq v_G \leq 5 \text{ V}$, odrediti i nacrtati karakteristiku $i_C(v_G)$.



Slika 1

- 2. a) [2]** Nacrtati diferencijalni pojačavač sa PMOS ulaznim tranzistorima i jednostrukim izlazom polarisan strujnim izvorom u sorsovima ulaznih tranzistora.
b) [3] Primenom bisekcione teoreme izračunati faktor potiskivanja signala srednje vrednosti pojačavača iz a).
c) [2] Nacrtati diferencijalni pojačavač sa PMOS ulaznim tranzistorima i jednostrukim izlazom polarisan otpornikom u sorsovima ulaznih tranzistora.
d) [3] Primenom bisekcione teoreme izračunati faktor potiskivanja signala srednje vrednosti pojačavača iz c).